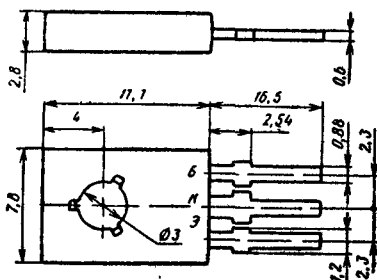


# КТ644 (А, Б, В, Г)

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры р-п-р универсальные. Предназначены для применения в усилителях низкой частоты, усилителях мощности, видеоусилителях различного назначения, импульсных и переключающих устройствах, в оконечных устройствах ЭВМ. Выпускаются в пластмассовом корпусе с гибкими выводами. Тип прибора указывается на корпусе.

Масса транзистора не более 1 г.

КТ644 (А-Г)



## Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ:

при  $U_{КБ}=10$  В,  $I_B=150$  мА:

КТ644А, КТ644В	40..120
КТ644Б, КТ644Г	100...300

при  $U_{КБ}=10$  В, КТ644А, КТ644В, не менее:

$I_B=0,1$ и 500 мА	20*
$I_B=1$ мА	25*
$I_B=10$ мА	35*

Модуль коэффициента передачи тока на высокой частоте при  $U_{КБ}=5$  В,  $I=30$  мА,  $f=100$  МГц

2...2,8\*...4,2\*

Граничное напряжение при  $I_K=10$  мА, не менее:

КТ644А, КТ644Б	60 В
КТ644В, КТ644Г	40 В

Напряжение насыщения коллектор — эмиттер:

при $I_K=150$ мА, $I_B=15$ мА	0,14*...0,18*...0,4 В
при $I_K=500$ мА, $I_B=50$ мА	0,45*..0,55*...1,6 В

Напряжение насыщения база — эмиттер при  $I_K=150$  мА,  $I_B=15$  мА, не более

1,3 В

Время рассасывания при  $I_K=150$  мА,  $I_B=15$  мА

80\*...110\*...180 нс

Емкость эмиттерного перехода при  $U_{ВБ}=0$ ,  $f=5 \cdot 10$  МГц, не более

50 пФ

Обратный ток коллектора при  $U_{КБ}=50$  В, не более

100 нА

Обратный ток эмиттера при  $U_{ВБ}=5$  В, не более

100 нА

## Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор — база	60 В
Постоянное напряжение эмиттер — база	5 В
Постоянный ток коллектора	0,6 А
Импульсный ток коллектора <sup>1</sup> при $t_u \leq 10$ мкс, $Q \geq 2$	1 А
Постоянный ток базы	0,2 А
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора <sup>2</sup> при $T = -60...+35$ °С	1 Вт
Импульсная рассеиваемая мощность <sup>1,3</sup> при $t_u \leq 10$ мкс, $Q \geq 2$ , $T_{\kappa} \leq +25$ °С	20 Вт
Тепловое сопротивление переход — корпус	10 °С/Вт
Тепловое сопротивление переход — среда	115 °С/Вт
Температура р-п перехода	+150 °С
Температура окружающей среды	-60...+125 °С

<sup>1</sup> При условии неперевышения  $P_{R, макс}$ .

<sup>2</sup> При использовании транзистора без теплоотвода и  $T > +35$  °С постоянная рассеиваемая мощность рассчитывается по формуле

$$P_{R, макс} \text{ Вт} = (150 - T) / R_{T(n-e)}$$

<sup>3</sup> При использовании транзистора с теплоотводом и  $T_{\kappa} > +25$  °С постоянная рассеиваемая мощность рассчитывается по формуле

$$P_{R, макс} \text{ Вт} = (150 - T_{\kappa}) / R_{T(n-\kappa)}$$

Минимальное расстояние от корпуса транзистора до места изгиба вывода 5 мм, радиус изгиба 1,5..2 мм. При изгибе необходимо принимать меры, исключающие передачу усилий на пластмассу. Кручение выводов запрещается.

Минимальное расстояние места пайки выводов от корпуса 5 мм. Температура пайки не более +250 °С, время пайки не более 10 с.